

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5961

SJ 20274—93

半导体分立器件 2CK84 型硅开关二极管详细规范

**Semiconductor discrete devices
Detail specification for silicon switching
diode for type 2CK84**

1993-05-11 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

半导体分立器件

2CK84 型硅开关二极管详细规范

SJ 20274—93

Semiconductor discrete devices

Detail specification for silicon switching

diode for type 2CK84

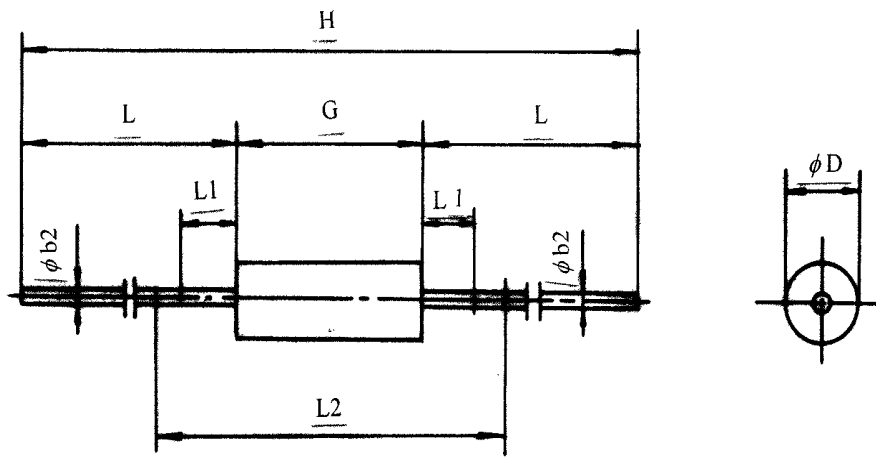
1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 2CK84 型硅开关二极管（以下简称器件）详细要求，该种器件按 GJB 33 《半导体分立器件总规范》的规定，提供产品保证的三个等级（GP、GT 和 GCT 级）。

1.2 外形尺寸

外形尺寸应符合 GB 7581 《半导体分立器件外形尺寸》中的 D2—02A 型，见图 1。



单位: mm

代号 尺寸 符号	D2—02A		
	最 小	公 称	最 大
ϕb_2	0.45		0.56
ϕD	1.50		2.20
G	3.50		5.40
H	54.30		
L	25.4		
L_1			2.5
L_2	10		

图 1 外形尺寸

1.3 最大额定值

型号	$I_O^{1)}$ $T_A=25^\circ\text{C}$ (mA)	$V_{(BR)}$ (V)	V_{RWM} (V)	I_{FSM} (A)	T_{OP} ($^\circ\text{C}$)	T_{stg} ($^\circ\text{C}$)
2CK84A	50	45	30	1	-55~150	-55~175
2CK84B	50	90	60	1		
2CK84C	50	135	90	1		
2CK84D	50	180	100	1		
2CK84E	50	225	150	1		
2CK84F	50	240	180	1		

注: 1) 当 $T_A > 25^\circ\text{C}$ 时按 $0.40\text{ mA}/^\circ\text{C}$ 速率线性地降额。1.4 主要电特性 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

型号	V_F $I_F=50\text{ mA}$ (V)	I_{R1} $V_R=V_{RWM}$ (μA)	I_{R2} $T_A=150^\circ\text{C}$ $V_R=V_{RWM}$ (μA)	t_π $I_F=I_R=20\text{ mA}$ $R_L=100\ \Omega$ (ns)	C_j $f=0.5\text{ MHz}$ $V_R=0\text{ V}$ (pF)
2CK84	1	0.1	100	150	30

2 引用文件

- GB 4023 半导体分立器件 第 2 部分 整流二极管
- GB 6571 小功率信号二极管、稳压及基准电压二极管测试方法
- GB 7581 半导体分立器件外形尺寸
- GJB 33 半导体分立器件总规范
- GJB 128 半导体分立器件试验方法